



HVT和RVT漏电对比



HVT和RVT漏电对比

单像素单元（慢链为NOR,不含ROM）的总漏电对比

单元	数量	HVT 单个 μW	RVT 单个 μW	HVT 合计 μW	RVT 合计 μW
反相器	5	0.000011412	0.000145800	0.000057060	0.000729000
2输入或非门	4	0.000024736	0.000140820	0.000098944	0.000563280
2输入与非门	3	0.000016825	0.000281410	0.000050475	0.000844230
3输入与非门	1	0.000024904	0.000413920	0.000024904	0.000413920
2输入与门	1	0.000026861	0.000237010	0.000026861	0.000237010
延时器	1	0.000141210	0.000421720	0.000141210	0.000421720
D触发器	2	0.000100750	0.000945360	0.000201500	0.001890720
锁存器	2	0.000076312	0.000630630	0.000152624	0.001261260
SR锁存器	2	0.000097318	0.000990930	0.000194636	0.001981860
总计	21			0.000948214	0.008343

注：表中漏电数据取自数据手册中各单元 Leakage表中所有输入状态中的最大值

数据分析

单元	数量	HVT 单个 μW	RVT 单个 μW	HVT 合计 μW	RVT 合计 μW
反相器	5	0.000011412	0.000145800	0.000057060	0.000729000
2输入或非门	4	0.000024736	0.000140820	0.000098944	0.000563280
2输入与非门	3	0.000016825	0.000281410	0.000050475	0.000844230
3输入与非门	1	0.000024904	0.000413920	0.000024904	0.000413920
2输入与门	1	0.000026861	0.000237010	0.000026861	0.000237010
延时器	1	0.000141210	0.000421720	0.000141210	0.000421720
D触发器	2	0.000100750	0.000945360	0.000201500	0.001890720
锁存器	2	0.000076312	0.000630630	0.000152624	0.001261260
SR锁存器	2	0.000097318	0.000990930	0.000194636	0.001981860
总计	21			0.000948214	0.008343

HVT单像素漏电功耗为 0.948214 nW ,漏电流为 0.7901783 nA
RVT单像素漏电功耗为 8.343 nW,漏电流为 6.9525 nA
漏电倍数 (RVT / HVT) 约为 8.7986467